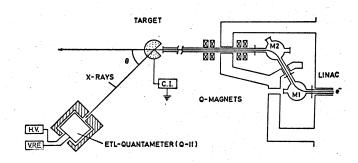
## ${ m II}-2$ ANGULAR DISTRIBUTIONS OF EMITTED X-RAYS FROM THICK Pb AND Cu TARGETS BOMBARDED BY 15 TO 33 MeV ELECTRONS

Takio Tomimasu, Kanou Hayashi\*and Takuya Tsujimura\*

Electrotechnical Laboratory, Tanashi, Tokyo

\*Giken Kogyo Co., Ltd., Hachioji, Tokyo

Angular distributions of emitted x-ray beam energy from thick Pb and Cu targets bombarded by 15 to 33 MeV electrons have been measured with an ETL type quantameter whose sensitivity is almost energy-independent in the wide energy range from 2 MeV to 1 GeV. To reduce the directional dependence of self absorption in the target, 270° sector-typed targets were used. Therefore no pronounced dip at 90° was observed in the angular distribution curve. The distribution curves were obtained at the three electron energies of 15, 25, and 33 MeV for each target. The distribution curve for unit electron beam energy rises with increasing electron energy at angles smaller than 10°, as expected. The distribition curve at angles from 10° to 107° for unit electron beam energy, however, shows an energy-independent and intrinsic shape for each target material.



四1 実験装置、配置

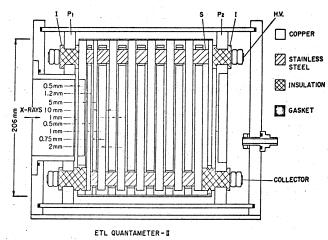
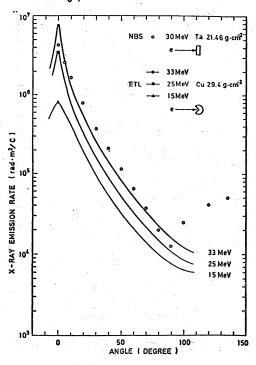


図2 電総研カンタメータ (Q-I)

この実験では標的物質として銅と筎を 選び、その形状は四 | に示すような270° 角形とし、電子ビームは角の要に照射す るようにした。これによって標的物質中 での制動放射線の滅衰率が放出方向によ って大きく変化しないようにした。角形 の標的はファラディ・カップとしても用 いられている。制動放射線の測定には 図2に示すような電総研カンタメータ<sup>1)</sup> (Q-I)が用いられ、制動放射線のエネ ルギーフルエンス (energy fluence: erg/cm²)が測定された。このカンタメ -9の校正定数の×線エネルギー依存性 は他のものと比べて極めて小さい(図3)。 エネルギーフルエンスから吸収線量への 授算は図4から 15 MeV ~ 33 MeV では 5000 erg/cm²を1rad として計算した。



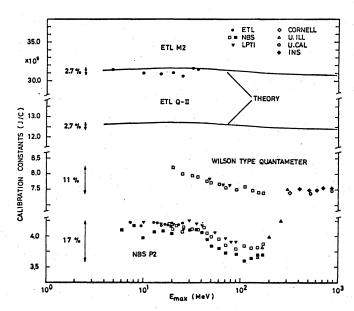


図3 種マのカンタナータの校正定数

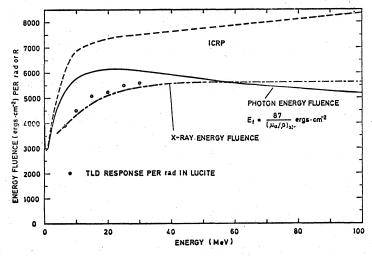
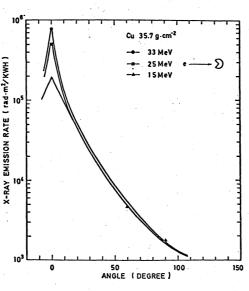


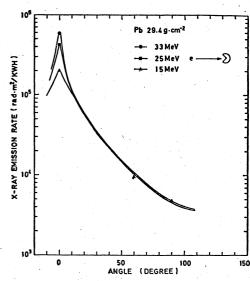
図4 1 rad まもは IR 当りのエネルギーフルエンス

図5は銅の角形標的に15,25,33 MeVの電子線を照射したときの制動放射線発生率を示したものである。NBSの測定値とはおなり良い一致を示してりるが、角形の標的を使用したためNBSの測定値に見出される90°近くでのくぼみはない。

図6は同じ銅角形標的からの制動放射線発生率を電子じームエネルギー | kw H 当に映算してものを
■ 図5 銅角形標的からの制動放射線の発生率
NBSの石標的からの測定値との比較

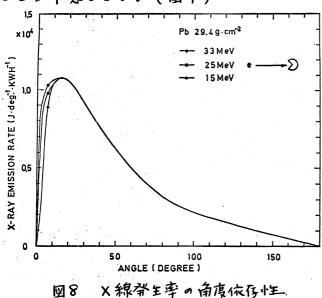
示す。電子ビームの方 のは A の が 10° が 1





の鉛角形標的からの× 図6 銅標的からの×線発生率 図7 鉛標的からの×線発生率 線発生率分布にも鮮明にあらわれている。図6、7ともに電子エネルギーが増加するに従って前か方向への×線発生率が増加することは予想通りである。しかし、この前か方向への×線発生率の増加は全立体角への×線発生率からみると僅がはものであることがわかる。図8は日か向1。当り枚出される×線発生率を示したものである。この分布曲線下の面積が全×線発生率を示すことにはる。電子エネルギーが15 MeVから33 MeV まで増加しても×線発生率は大きくは変らないことがわかる。25 MeV 電子が鉛角形標的に当った場合、エネルギーの67%が×線に変換されており、前方の10。以内は別としても他の方向への

X線発生率は電子エネルギーとともに大きく変化しないことが予想できる。(図9)



1) T. Tomimasu: J. Phys. Soc. Japan. 25, 655 (1968)

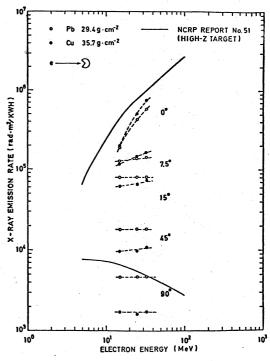


图9 X 線幹生率, 電子功能依例生